



Transistor de Pot, RF, Fet, Canal N, 8 W, 7.5 Vcc

SKU: MRF-1517-T1 Marca: PARTS Categoría: Misceláneo

\$1,005.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN



El Transistor **MRF1517T1** está diseñado para aplicaciones comerciales e industriales de banda ancha en frecuencias de hasta 520 MHz. La alta ganancia y el rendimiento de banda ancha de este dispositivo lo hacen ideal para aplicaciones de amplificador de fuente común de gran señal en equipos FM portátiles de 7,5 voltios

Rendimiento especificado @ 520 MHz, 7.5 Volts.

Potencia de salida 8 Watts.

Ganancia de potencia 11dB.

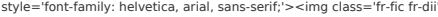
Eficiencia- 55%.

Caracterizado con parámetros de impedancia de señal grande equivalente en serie.

Excelente estabilidad térmica.

Capaz de manejar 20:1 VSWR, @ 9,5 Vcc, 520 MHz, 2 dB de sobremodulación.

Envase de plástico de montaje superficial de potencia RF.





ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta ganancia de potencia de 11 dB
Característica 2	Eficiencia del 55% en operación RF
Característica 3	Operación estable hasta 520 MHz
Característica 4	Excelente estabilidad térmica integrada
Característica 5	Soporta VSWR 20:1 en condiciones extremas
Característica 6	Encapsulado SMD para montaje superficial